

Тематический указатель статей, опубликованных в 2010 году

Фундаментальные исследования

Гончаров В.А., Азанова И.В., Васекин Б.В. Модель неравновесной кристаллизации для численного решения задачи роста полупроводниковых кристаллов из расплавов. №5(85), с. 5.

Данилов А.А., Терещенко С.А., Пьянов И.В., Гавриков А.И. Определение коэффициентов поглощения и рассеяния сильнорассеивающих сред на основе измерений временных распределений интенсивности лазерных импульсов. №4(84), с. 3.

Лавров И.В. Эффективная проводимость поликристаллической среды. Одноосная текстура и двуосные кристаллиты. №3(83), с. 3.

Мороча А.К. К теории волн Лява в гетероструктурах с гексагональной симметрией. №1(81), с. 3.

Материалы электронной техники

Яремчук А. Ф. Контроль качества кремниевых слитков методом спада фотопроводимости. №6(86), с. 3.

Технология микроэлектроники

Багинский И.Л., Косцов Э.Г. Обратимый быстродействующий «электростатический клей». №2(82), с. 18.

Белов А.Н., Гаврилин И.М., Гаврилов С.А., Дронов А.А. Особенности морфологии пленок оксида титана, полученных вытягиванием кремниевых подложек из раствора. №6(86), с. 8.

Виноградов А.И., Зарянкин Н.М., Прокопьев Е.П., Тимошенко С.П., Михайлов Ю.А. Оптимизация параметров процесса глубокого плазмохимического травления кремния для элементов МЭМС. №2(82), с. 3.

Гаврилов С.А., Железнякова А.В., Редичев Е.Н., Попенко Н.И. Влияние состава растворов-прекурсоров на оптические свойства пленок In_2S_3 , осаждаемых ионным напылением. №2(82), с. 10.

Горлов М.И., Смирнов Д.Ю., Золотарева Е.А. Влияние рентгеновского излучения на низкочастотный шум ИС. №4(84), с. 8.

Дмитриев А.Н., Чердниченко Д.И. Формирование слоев графена сублимацией карбида кремния в вакууме сканирующим источником тепла. №6(86), с. 12.

Сагунова И.В., Шевяков В.И., Гаврилов С.А., Белов А.Н. Кинетика локального зондового окисления сверхтонких пленок металлов V, Nb, Ta, Ti, TiN, W. №3(83), с. 13.

Тимошенко С.П., Бойко А.Н., Симонов Б.М., Заводян А.В. Технологии вакуумной герметизации МЭМС. Обзор. №1(81), с. 11.

Микроэлектронные приборы и системы

- Бирюков В.Н.** Оценка точности определения параметров моделей полевого транзистора. №5(85), с. 22.
- Галалу В.Г.** Оценка достижимой разрядности базовой схемы преобразователя код-напряжение для гибридного исполнения. №6(86), с. 19.
- Добрынин А.В., Харитонова Т.В., Казаков В.К.** Анализ тепловых процессов в пьезокерамическом актюаторе. №1(81), с. 38.
- Колеров А.Н.** Режимы генерации лазерного импульса, управляемые полупроводниковыми фильтрами. №1(81), с. 30.
- Малашевич Н. И., Росляков А. С., Поломошнов С. А., Фёдоров Р. А.** Микросхема для обработки низкочастотного сигнала с сейсмодатчика. №6(86), с. 29.
- Новиков С.Г., Гурин Н.Т., Корнеев И.В.** Моделирование и исследование биполярного транзистора с передаточной N -образной вольт-амперной характеристикой. №4(84), с. 14.
- Орда-Жигулина М.В., Алексеев Ю.И.** Амплитудно-частотное преобразование при СВЧ-модуляции инжекционных полупроводниковых лазеров. №6(86), с. 25.
- Сергеев В.А., Фролов И.В., Широков А.А., Щербатюк Ю.Н.** Вероятностные характеристики электрических шумов гетеропереходных светодиодов. №5(85), с. 15.
- Тимошенко В.П.** Сверхширокополосный трансивер гигагерцового диапазона на SiGe-транзисторах. №3(83), с. 20.
- Тимошенко В.П.** Интегральный эквалайзер гигагерцового диапазона на гетеропереходных биполярных транзисторах. №4(84), с. 20.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Скворцов В.С., Мерданов М.К.** Волноводные фотонные кристаллы с характеристиками, управляемыми p - i - n -диодами. №1(81), с. 24.

Нанотехнология

- Агеев О.А., Алябьева Н.И., Коноплев Б.Г., Поляков В.В., Смирнов В.А.** Фотоактивация процессов формирования наноструктур методом локального анодного окисления пленки титана. №2(82), с. 23.
- Булярский С.В., Пятилова О.В., Цыганцов А.В., Басаев А.С., Галперин В.А., Павлов А.А., Шаман Ю.П.** Расчет параметров нуклеации кластеров катализаторов для синтеза углеродных нанотрубок. №3(83), с. 38.
- Булярский С.В., Пятилова О.В., Цыганцов А.В., Басаев А.С., Галперин В.А., Павлов А.А., Шаман Ю.П.** Термодинамика формирования кластеров катализаторов для роста углеродных нанотрубок. №1(81), с. 50.
- Герасименко А.Ю., Губарьков О.В., Ичкитидзе Л.П., Подгаецкий В.М., Селищев С.В., Пономарева О.В.** Нанокompозитный припой для лазерной сварки биологических тканей. №4(84), с. 33.
- Григорашвили Ю.Е., Бухлин А.В., Верюжский И.В.** Формирование наноразмерных сверхпроводниковых структур с критической температурой выше 100 К. №2(82), с. 32.
- Громов Д.В., Елесин В.В., Петров Г.В., Бобринецкий И.И., Неволин В.К.** Радиационные эффекты в элементах наноэлектроники. №1(81), с. 45.
- Громов Д.Г., Жигальский Г.П., Карев А.В., Карев И.А., Чулков И.С., Шмелёв С.С.** Флуктуационные явления в пленках никеля нанометровой толщины вблизи температуры плавления. №3(83), с. 31.
- Дубков С.В., Гаврилов С.А., Громов Д.Г., Красулин Г.А.** Низкотемпературный процесс формирования углеродных трубчатых и графеновых структур. №4(84), с. 28.
- Руднев А.В., Хлынов А.В.** Механизм электрокристаллизации кобальта на монокристаллах Au(111). №2(82), с. 37.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В.** Электрофизические свойства композитов с включениями углеродных нанотрубок, частиц мелкодисперсного графита и ферритовых микрочастиц. №5(85), с. 28.

Усанов Д.А., Скрипаль Ал.В., Скрипаль Ан.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Али Бакуи. Измерение параметров нанометровых пленок оптическими и радиоволновыми методами. №3(83), с. 44.

Схемотехника и проектирование

Бачманов В.А., Бобриков С.А., Заболотнов И.В. Диакоптические методы временной характеристики статических ЗУПВ КМОП, компилируемых по субмикронным проектным нормам. №4(84), с. 42.

Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Егоров Ю.Б. Статистический анализ сложных функциональных блоков. №5(85), с. 41.

Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Егоров Ю.Б. Методы ускоренной характеристики библиотек элементов СБИС с контролем заданной точности. №3(83), с. 51.

Заглядин Г. Г., Сырцов И. А., Школа А. В. Алгоритм синтеза множества остовных деревьев для выполнения глобальной трассировки заказных СБИС. №5(85), с. 36.

Перминов В.Н., Макаров С.В., Кокин С.А., Веселов А.Е. Использование параметрической оптимизации при проектировании библиотечных элементов СБИС и специализированных интерфейсов нанoeлектронных устройств. №2(82), с. 42.

Эннс А.В. Метод кусочной аппроксимации температурной зависимости источника опорного напряжения. №4(84), с. 52.

Микросистемы

Тимошенко С.П., Бойко А.Н., Симонов Б.М. Методы сборки и монтажа макетных образцов микроэлектромеханических систем. №4(84), с. 58.

Микропроцессорная техника

Беклемишев Д.Н., Переверзев А.Л., Твердунов Д.В. Однокристалльный вычислитель для беспилотного летательного аппарата. №6(86), с. 33.

Беляев А.А. Оптимальная по производительности глубина программного конвейера для приложений с программными переходами и зависимостью по данным. №2(82), с. 48.

Лисов О.И., Махалов А.А. Оценка эффективности двух вариантов реализации диспетчера памяти для ядра архитектуры «Орхидея». №3(83), с. 61.

Штерн Ю.И., Кожневиков Я.С., Рыков В.М., Миронов Р.Е., Штерн М.Ю. Разработка математических моделей для интеллектуальных систем управления прецизионным термическим оборудованием. №2(82), с. 52.

Информационные технологии

Амербаев В.М., Балака Е.С. Методы вычисления гауссовых логарифмов N переменных над полем Галуа $GF(p)$. №4(84), с. 64.

Гончаров В.А., Балдина Н.А., Дорошенко Е.С., Подкопаев И.В. Численное моделирование процесса кристаллизации полупроводников с использованием параллельных вычислений. №6(86), с. 49.

Ким А.А. Разработка низкоплотностного сверточного кодера с генератором терминирующей последовательности для пакетной передачи данных. №1(81), с. 63.

Кузнецов В.С., Мордасов К.А. Быстрое декодирование на основе пассивной согласованной фильтрации длинных псевдослучайных кодов. №1(81), с. 57.

Матюшкин И.В., Хамухин А.В. Применение языка UML при проектировании клеточных автоматов. №6(86), с. 39.

Трещановский П.А. Методы управления качеством обслуживания в мультисервисных сетях абонентского доступа. №3(83), с. 68.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Булычев Ю.Г., Мозоль А.А., Вернигора В.Н. Оперативное ранжирование целей по дальности в комплексах радиоэлектронного подавления по минимальному числу угломерно-мощностных измерений. №1(81), с. 68.

Демьяненко А.В., Алексеев Ю.И. Использование лавинно-пролетного диода для детектирования СВЧ амплитудно-модулированных оптических колебаний. №4(84), с. 70.

Колеров А.Н., Онищенко Д.В., Рухлов Д.С. Многоканальный фотоэлектрический регистратор эмиссионных спектров. №6(86), с. 67.

Кочетков В.Ю. Квазикогерентный алгоритмический демодулятор с подстройкой частоты по информационному сигналу. №2(82), с. 60.

Курганов В.В., Лялин К.С., Приходько Д.В. Построение модели системы встроенного контроля антенных решеток для радиолокаторов с синтезированной апертурой. №5(85), с. 48.

Хвалин А.Л., Игнатьев А.А., Самолданов В.Н. Микрополосковые преобразователи энергии электромагнитного поля на основе сферических ЖИГ-резонаторов. №4(84), с. 75.

Широ Е.Г., Широ Г.Э. Метод снижения спекл-шума в радиолокационных изображениях. №6(86), с. 58.

Яремчук А.Ф., Алексеев А.В., Короткевич А.В. Применение коротких световых импульсов для измерения параметров солнечного элемента. №2(82), с. 65.

Методы и техника измерений

Алексеев А.М., Комков В.Н., Краснобородько С.Ю., Шевяков В.И., Шубин А.Б. Особенности методики трехпроходных измерений в магнитной силовой микроскопии. №6(86), с. 63.

Быков В.А., Кузнецов Е.В., Пьянков Е.С. Уменьшение влияния температурного дрейфа в сканирующих зондовых микроскопах. №5(85), с. 58.

Карташов Д.А., Герасименко Н.Н., Медетов Н.А., Турьянский А.Г., Цехош В.И. Эффективность генетического алгоритма при анализе данных рентгеновской рефлектометрии. №3(83), с. 74.

Шадов М.Б. Особенность реализации метода затухания фотопроводимости при измерении комбинационных параметров полупроводника. №1(81), с. 75.

Биомедицинская электроника

Базаев Н.А., Гринвальд В.М., Лазарев В.В. Электронная система тестирования технических характеристик гемодиализных аппаратов. №4(84), с. 80.

Тельшев Д.В. Алгоритм определения фибрилляции желудочков для автоматических наружных дефибрилляторов. №1(81), с. 80.

Проблемы высшего образования

Баин А.М. Математическая модель системы дистанционного обучения. №2(82), с. 71.

Краткие сообщения

Артамонов Д.С. Метод обеспечения динамической частичной реконфигурируемости аппаратуры высокопроизводительного систолического процессора. №5(85), с. 68.

- Аунг Пхио Вин, Трояновский В.М.* Сравнение методов обнаружения периодичности стохастических сигналов. №2(82), с. 84.
- Гайдуков Г.Н., Жаринова Н.Н.* Влияние упругого взаимодействия примесных атомов на их распределение в системе двумерных квантовых точек. №2(82), с. 76.
- Гуреев А.В., Миронов Ю.Б.* Условие устойчивости мобильной беспроводной сети. №6(86), с. 80.
- Егоркина Р.Ю.* Модернизация системы мониторинга отходов производства изделий нано- и микро-системной техники. №3(83), с. 90.
- Еришов М.Д., Маслобоев Ю.П., Потанов Д.А., Титенок С.А.* Модель прохождения ультракороткого лазерного импульса через однородный рассеивающий слой. №6(86), с. 72.
- Крупкина Т.Ю., Пьянков Е.С., Алексеев А.А.* Улучшение системы позиционирования в сканирующей зондовой микроскопии. №6(86), с. 78.
- Крупкина Т.Ю., Родионов Д.В.* Анализ распределения заряда в интегральных наноразмерных КМДП-структурах. №4(84), с. 89.
- Курина В.В.* Оценка эффективности применения дискретного псевдокосинусного преобразования для сжатия изображений. №2(82), с. 78.
- Локтев Д.В., Красулин Г.А., Зиновьев Д.В.* Тепловой микроэлектронный датчик перемещений №3(83), с. 88.
- Морозова Н.В., Смирнов А.В., Чжи Я Аунг.* Коррекция изображения при выводе на печатающее устройство. №1(81), с. 90.
- Неустроев С.А.* Тетраэдрические связи кубического углерода. №4(84), с. 86.
- Николаев А.В.* Анализ энергопотребления элементов конденсаторно-транзисторной логики методами приборно-технологического моделирования. №5(85), с. 66.
- Новиков С.Н., Тимошенков С.П., Сухоруков Д.О.* Зависимость работы выхода электрона от условий окисления Si(100). №3(83), с. 86.
- Опаричев Е.Б., Каримбеков М.А., Опаричев А.Б., Вигдорович В.Н.* Классификация конструкторско-технологических решений пленочных термоэлектрических преобразователей измерительного назначения. №3(83), с. 79.
- Петросяня К.О., Орехов Е.В., Самбурский Л.М., Харитонов И.А., Ятманов А.П.* Трехмерное моделирование радиационных токов утечки в субмикронных МОП-транзисторах со структурой кремний–на–изоляторе. №2(82), с. 81.
- Петросяня К.О., Самбурский Л.М., Харитонов И.А., Ятманов А.П.* BSIMSOI-RAD – макро-модель КНИ/КНС МОП-транзистора для схемотехнического расчета КМОП БИС с учетом радиационных эффектов. №5(85), с. 64.
- Погалов А.И., Блинов Г.А., Чугунов Е.Ю.* Моделирование термопрочности многокристалльных микромодулей. №5(85), с. 73.
- Портнов Е.М., Вин Мьинт Зо.* Статическая модель автоматизированного расходомера с жидкостными метками. №1(81), с. 88.
- Саркисов А.Ш., Риттер А.В., Саркисов В.А.* Измерительный датчик тока с PIC-контроллером. №3(83), с. 82.
- Сергеенко В.С.* Кодек речи для устройств мобильной связи. №6(86), с. 76.
- Соколова Т.Ю.* Использование внешних ссылок в среде автоматизированного проектирования. №5(85), с. 71.
- Соколова Т.Ю., Руденский Р.В.* Компьютерное геометрическое моделирование приборов и устройств электронной техники на базе пакета SolidWorks. №4(84), с. 91.
- Хаханян С.Ю.* Контроль чистоты реагентов безотходных технологий очистки поверхности полупроводниковых структур методом инверсионной вольтамперометрии. №6(86), с. 74.

Хаханин С.Ю. Методы и средства контроля чистоты реагентов в безотходных технологиях очистки поверхности полупроводниковых структур. №2(82), с. 83.

Щёголева Т.В., Образцов Р.М., Добрынин А.В. Частотные характеристики поддерживающих конструкций биморфного пьезокерамического элемента балочного гироскопа. №3(83), с. 84.

Юбилеи

Гаврилов С.А., Рыгалин Б.Н. Научно-исследовательский комплекс МИЭТ. №5(85), с. 85.

Геннадью Георгиевичу Казённову – 75 лет. №2(82), с. 93.

Гуляеву Юрию Васильевичу – 75 лет. №6(86), с. 83.

Жоресу Ивановичу Алфёрову – 80 лет. №2(82), с. 91.

Игнатова И.Г., Матына Л.И., Хвостик Т.В. МИЭТ – инновации в образовании. №5(85), с. 81.

К 80-летию со дня рождения Малинина А.Ю. №6(86), с. 85.

Чаплыгин Ю.А. МИЭТу – 45. №5(85), с. 77.

Конференции. Семинары. Выставки

Вернер В.Д., Ильков В.К. Инновации – тактика выхода из кризиса (выставка «Продуктроника – 2009», г. Мюнхен, Германия). №2(82), с. 86.

Об итогах 17-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2010». №3(83), с. 92.

Об итогах работы V Международной юбилейной научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, технике и образовании» (22 сентября – 2 октября 2009 г., Республика Абхазия, г. Пицунда). №1(81), с. 93.

Сессия годовичного собрания секции по проблемам функциональных материалов электронной техники Научного совета по новым материалам при Международной ассоциации Академии наук. №5(85), с. 76.

Международная научно-техническая конференция с элементами научной школы для молодежи «Проектирование систем на кристалле: тенденции развития и проблемы» (19–21 октября 2010 г., Россия, г. Москва). №6(86), с. 87.

Памяти Камиля Ахметовича Валиева. №5(85), с. 92.